

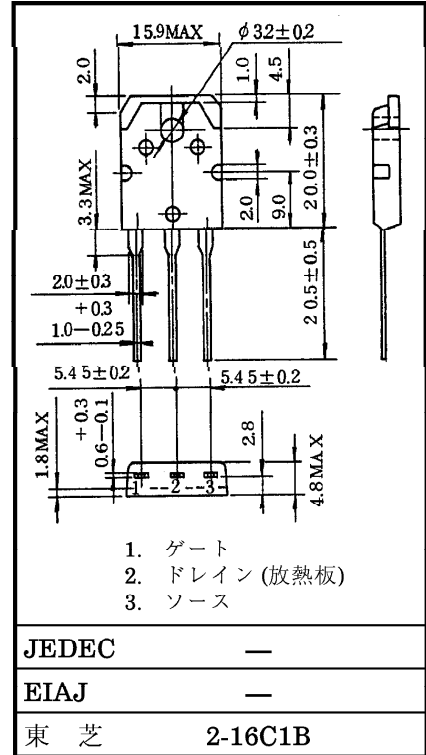
東芝電界効果トランジスタ シリコンチャネルMOS形

2SJ200

○ 低周波電力増幅用

単位：mm

- 高耐圧です。 : $V_{DSS} = -180V$
- 高順方向伝達アドミタンスです。 : $|Y_{fs}| = 4.0S$ (標準)
- 2SK1529とコンプリメンタリになります。



最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	-180	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	± 20	V
ドレイン電流	I_D	-10	A
許容損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_D	120	W
チャネル温度	T_{ch}	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

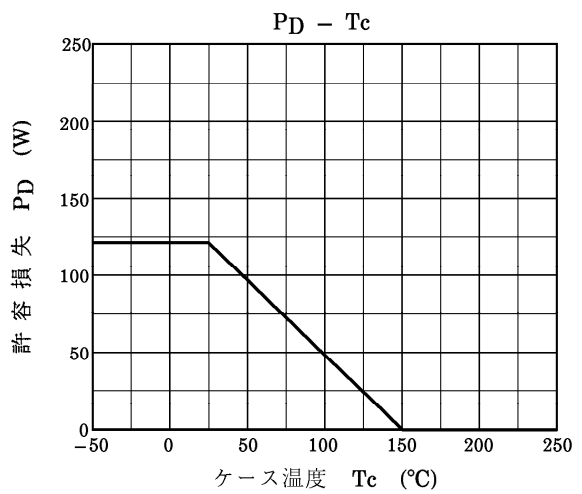
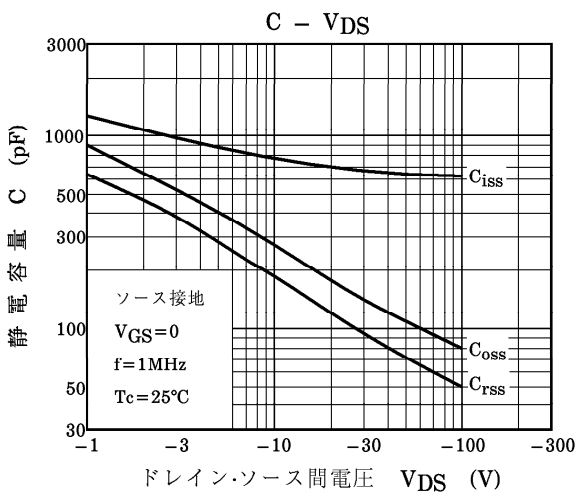
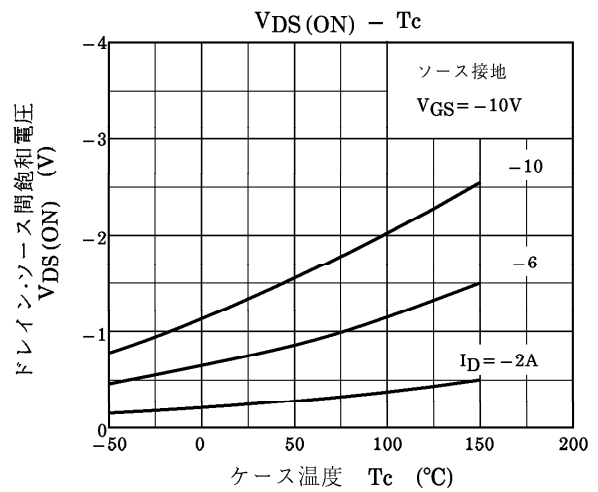
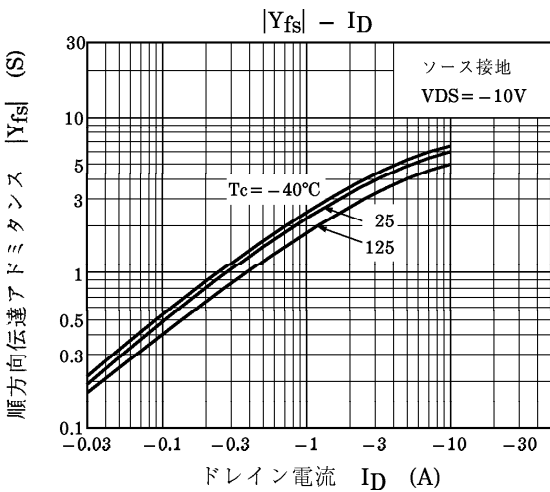
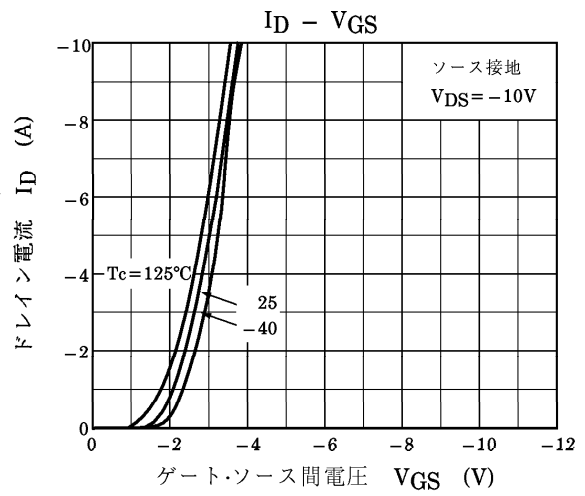
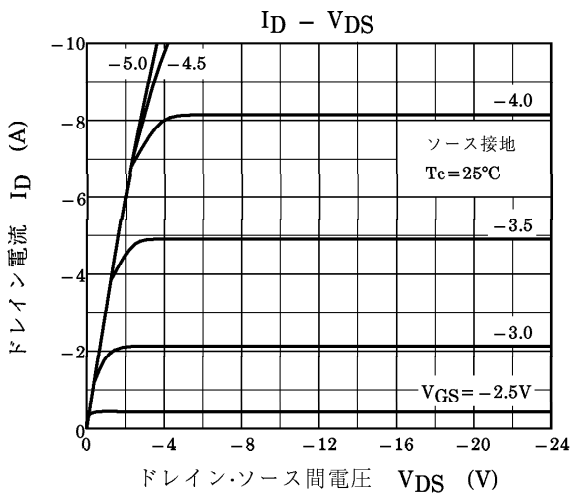
項 目	記 号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単 位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{DS} = 0, V_{GS} = \pm 20V$	—	—	± 0.5	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = -10mA, V_{GS} = 0$	-180	—	—	V
ゲート・ソース間しゃ断電圧	$V_{GS(OFF)}$ (注)	$V_{DS} = -10V, I_D = -0.1A$	-0.8	—	-2.8	V
ドレイン・ソース間飽和電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D = -6A, V_{GS} = -10V$	—	-1.5	-5.0	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = -10V, I_D = -3A$	—	4.0	—	S
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS} = -30V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	1300	—	pF
出 力 容 量	C_{oss}	$V_{DS} = -30V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	350	—	pF
帰 還 容 量	C_{rss}	$V_{DS} = -30V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	200	—	pF

(注) $V_{GS(OFF)}$ 区分 O: -0.8~-1.6, Y: -1.4~-2.8

この製品はMOS構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。

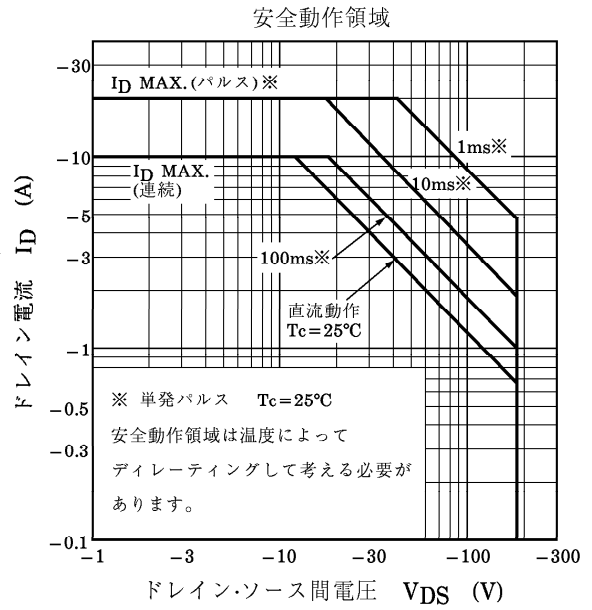
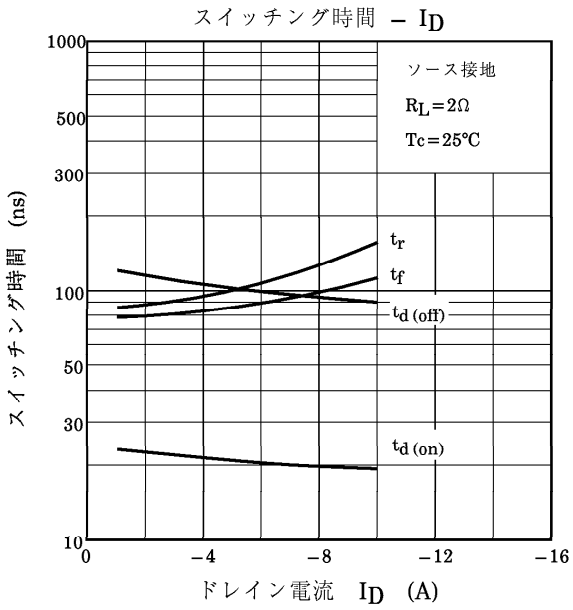
960917TAA2

● 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用頂く場合は、半導体製品の誤作動や故障により、他人の生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、装置の安全設計を行うことをお願いします。なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用頂くとともに、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご活用ください。

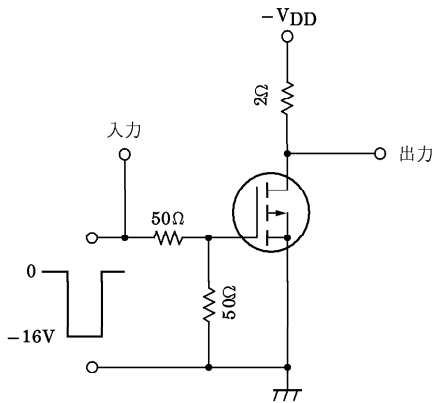


960917TAA2'

● 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に
 対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
 ● 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。



スイッチング時間測定回路



応答波形

